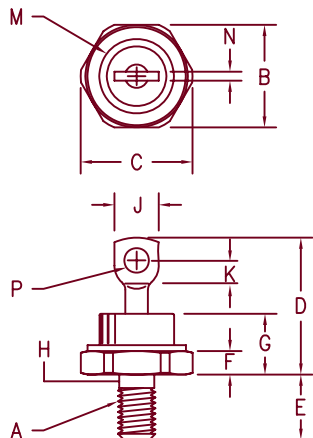


80 Amp Schottky Rectifier SBR8040 — SBR8050



Notes:

1. Full threads within 2 1/2 threads
2. Standard Polarity: Stud is Cathode
Reverse Polarity: Stud is Anode

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	---	---	---	---	1/4-28
B	.669	.688	17.00	17.47	
C	---	.794	---	20.16	
D	.750	1.00	19.05	25.40	
E	.422	.453	10.72	11.50	
F	.115	.200	2.93	5.08	
G	---	.450	---	11.43	
H	.220	.249	5.59	6.32	1
J	---	.375	---	9.52	
K	.156	---	3.97	---	
M	---	.510	---	12.95	Dia
N	---	.080	---	2.03	
P	.140	.175	3.56	4.44	Dia

DO-203AB (DO-5)

Microsemi Catalog Number	Industry Part Number	Working Reverse Voltage	Peak Reverse Voltage
SBR8040 *	75HQ035, 85HQ035 75HQ040, 85HQ040 MBR8040	40V	40V
SBR8045 *	75HQ045, 85HQ045 MBR8045	45V	45V
SBR8050 *		50V	50V

*Add Suffix R For Reverse Polarity

- Schottky Barrier Rectifier
- 175°C Junction Temperature
- Guard Ring Protection
- Reverse Energy Tested
- VRRM - 40 to 50 Volts
- 80 Amperes

Electrical Characteristics

Average forward current,	I _{F(AV)} = 80 Amps	T _C = 130°C, Square wave, R _{θJC} = 0.8°C/W
Maximum surge current,	I _{FSM} = 1200 Amps	8.3 ms, half sine T _J = 175°C
Max repetitive peak reverse current	I _{R(OV)} = 2 Amps	f = 1 KHz, 25°C, 1 μsec Square wave
Max peak forward voltage,	V _{FM} = 0.58 Volts	I _{FM} = 80A, T _J = 175°C*
Max peak forward voltage,	V _{FM} = 0.74 Volts	I _{FM} = 80A, T _J = 25°C*
Max peak reverse current	I _{RM} = 30 mA	V _{RRM} , T _J = 125°C*
Max peak reverse current	I _{RM} = 2 mA	V _{RRM} , T _J = 25°C
Typical junction capacitance	C _J = 2300 pF	V _R = 5.0V, T _J = 25°C

*Pulse test: Pulse width 300 μsec, Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temp range	T _{STG}	-65°C to +175°C
Operating junction temp range	T _J	-65°C to +175°C
Max thermal resistance	R _{θJC}	0.8°C/W Junction to sink
Typical thermal resistance (greased)	R _{θCS}	0.5°C/W Case to sink
Mounting torque		25-30 inch pounds
Weight		.54 ounce (15.3 grams) typical



6 Lake Street
Lawrence, MA 01841
PH: (978) 620-2600
FAX: (978) 689-0803
www.microsemi.com

05-30-07 Rev. 3

SBR8040 — SBR8050

Figure 1
Typical Forward Characteristics

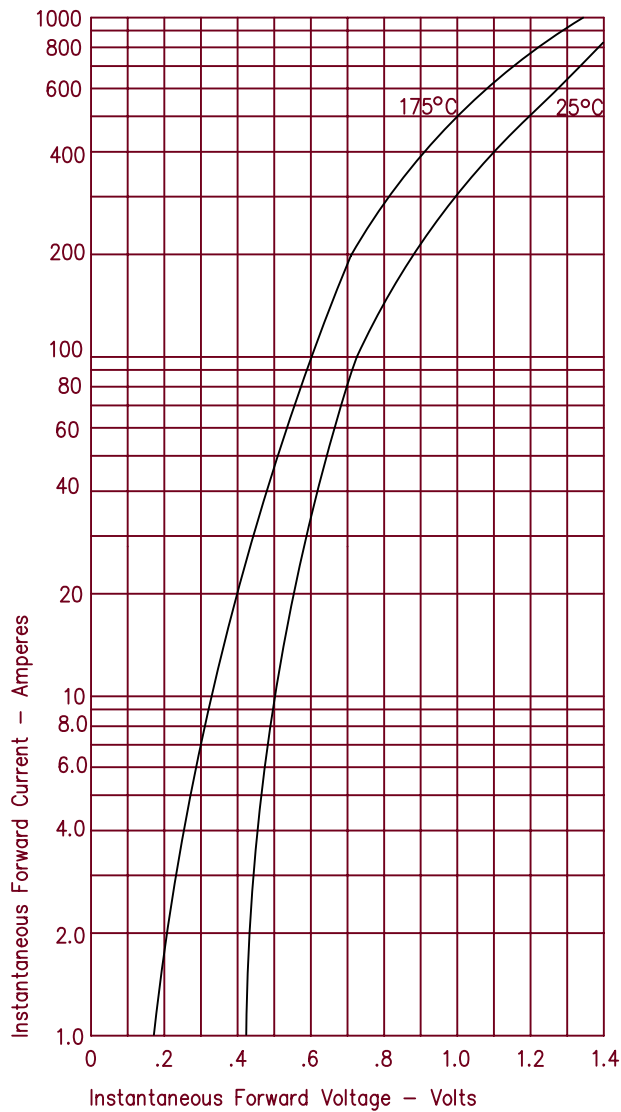


Figure 2
Typical Reverse Characteristics

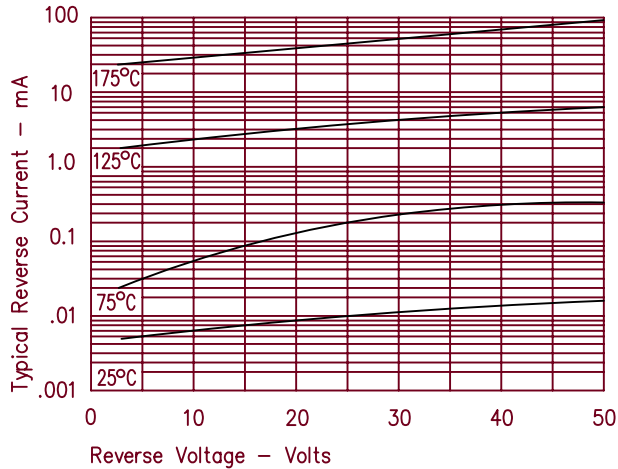


Figure 3
Typical Junction Capacitance

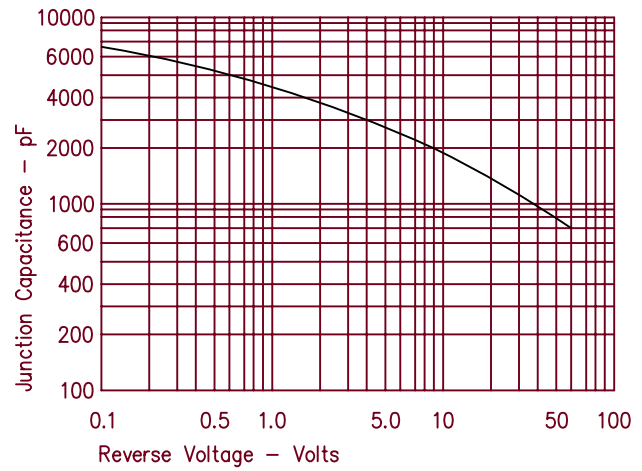


Figure 4
Forward Current Derating

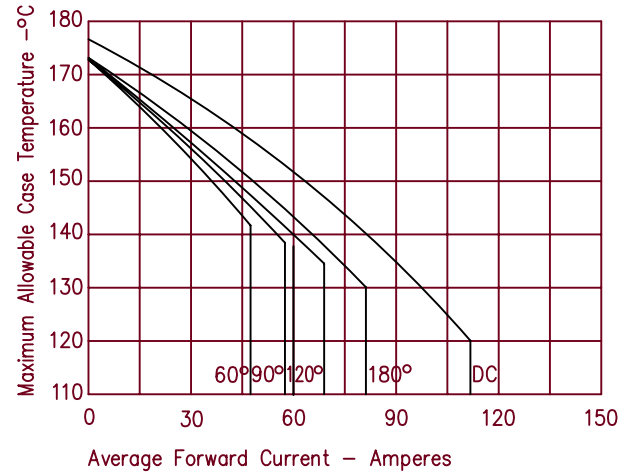
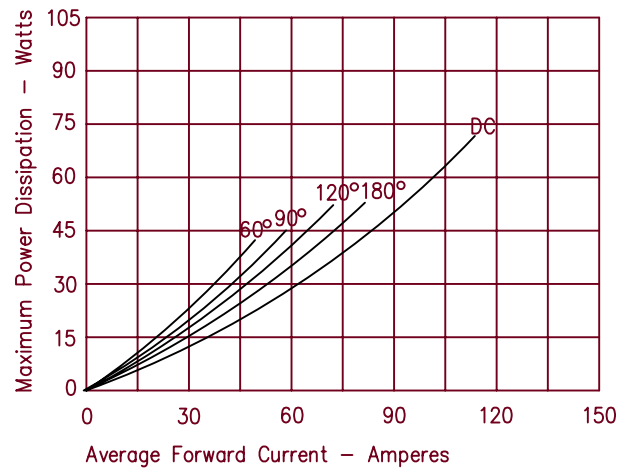


Figure 5
Maximum Forward Power Dissipation





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.